

Dkłady 16384-bitowej pamięci ROM charakteryzują się:

- trójstanowymi wyjściami danych,
- możliwością pełnej współpracy z układami TTL,
- dekodern i trzema wejściami uaktywniającymi CS<sub>1</sub>-CS<sub>3</sub> pozwalającymi na współpracę do 8 pamięci w jednym systemie.

Zawartość matrycy pamięci i dekodera wejść uaktywniających programowana jest maską przez producenta i oznaczona dwuliterowym kodem /w miejscu liter XX/.

## MCY 7316NXX

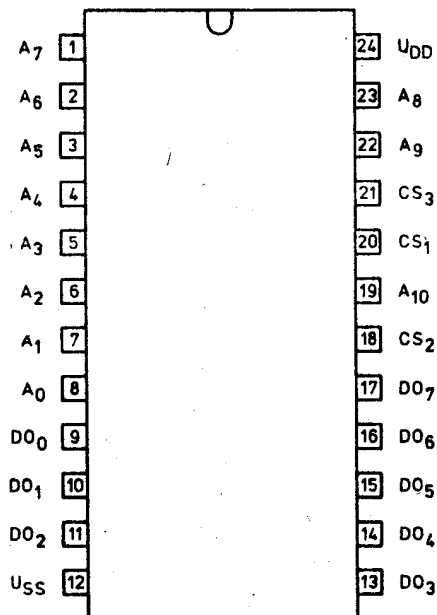
Pamięć statyczna ROM  
8 x 2048 bitów

Informacja wstępna

LSI NMOS  
Bramka krzemowa

Obudowa CE 73

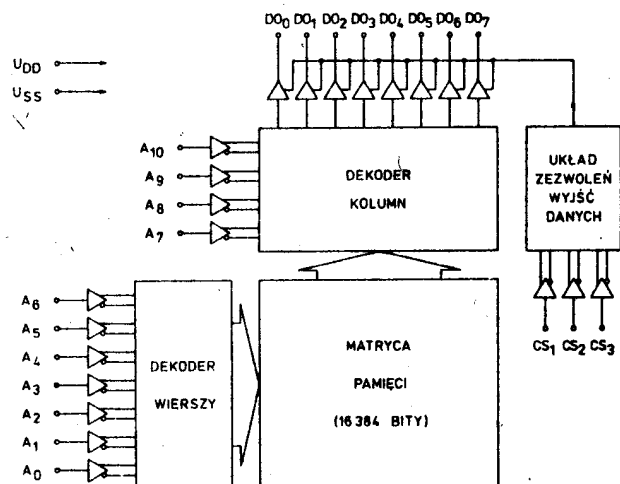
### Układ wyprowadzeń



### Opis wyprowadzeń

U<sub>SS</sub>, U<sub>DD</sub> - wejścia zasilające  
A<sub>0</sub> ÷ A<sub>10</sub> - wejścia adresowe  
CS<sub>1</sub> ÷ CS<sub>3</sub> - wejścia wyboru układu  
DO<sub>0</sub> ÷ DO<sub>7</sub> - wyjścia danych

Blokowy schemat wewnętrzny



## Parametry dopuszczalne

$/U_{SS} = 0 \text{ V}/$

Oznaczenie	Nazwa	Jedn.	Wartość	
			min	max
$U_{DD}$	Napięcie zasilania	V	-0,5	7
$U_W$	Napięcie na pozostałych wyprowadzeniach	V	-0,5	7
$P_D$	Moc rozpraszana	W		1
$t_{amb}$	Temperatura otoczenia w czasie pracy	$^{\circ}\text{C}$	0	+70
$t_{stg}$	Temperatura przechowywania	$^{\circ}\text{C}$	-40	+125

## Parametry charakterystyczne statyczne

$/U_{SS} = 0 \text{ V}; t_{amb} = +25^{\circ}\text{C}/$

Oznaczenie	Nazwa	Jedn.	Wartość		Warunki pomiaru
			min	max	
$U_{DD}$	Napięcie zasilania	V	4,75	5,25	
$U_{IH}$	Napięcie wejściowe w stanie wysokim	V	2,4		
$U_{IL}$	Napięcie wejściowe w stanie niskim	V		0,8	
$I_{LI}$	Prąd upływności wejść	$\mu\text{A}$		10	wejścia razem $U_I = 0 - 5,25 \text{ V}$
$U_{OH}$	Napięcie wyjściowe w stanie wysokim	V	2,4		$I_{OH} = -400 \mu\text{A}$
$U_{OL}$	Napięcie wyjściowe w stanie niskim	V		0,4	$I_{OL} = 2,1 \text{ mA}$
$I_{DD}$	Prąd zasilania	mA		120	$U_I = U_{DD} = 5,25 \text{ V}$ wyjścia otwarte

## Parametry charakterystyczne pojemności

$/U_{SS} = 0 \text{ V}; t_{amb} = +25^{\circ}\text{C}/$

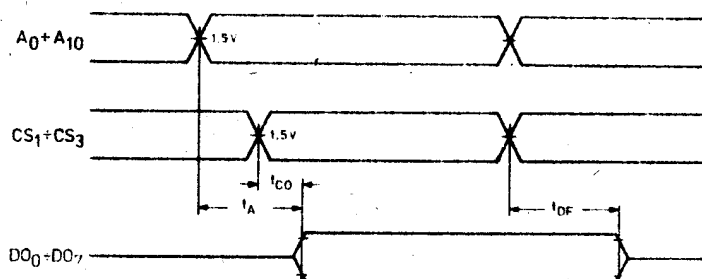
Oznaczenie	Nazwa	Jedn.	Wartość max	Warunki pomiaru
$C_I$	Pojemność wejściowa	pF	10	$f = 1 \text{ MHz}$
$C_O$	Pojemność wyjściowa	pF	15	

## Parametry charakterystyczne dynamiczne

/obciążenie: 1 bramka TTL i pojemność 100 pF/

Oznaczenie	Nazwa	Jedn.	Wartość	
			min	max
$t_A$	Czas dostępu względem adresu	ns		450
$t_{CO}$	Czas dostępu względem zezwolenia CS	ns		120
$t_{DF}$	Czas opóźnienia czasu nieaktywnego wyjść względem zakazu CS	ns	10	100

### CYKL ODCZYTU



Definicje parametrów dynamicznych